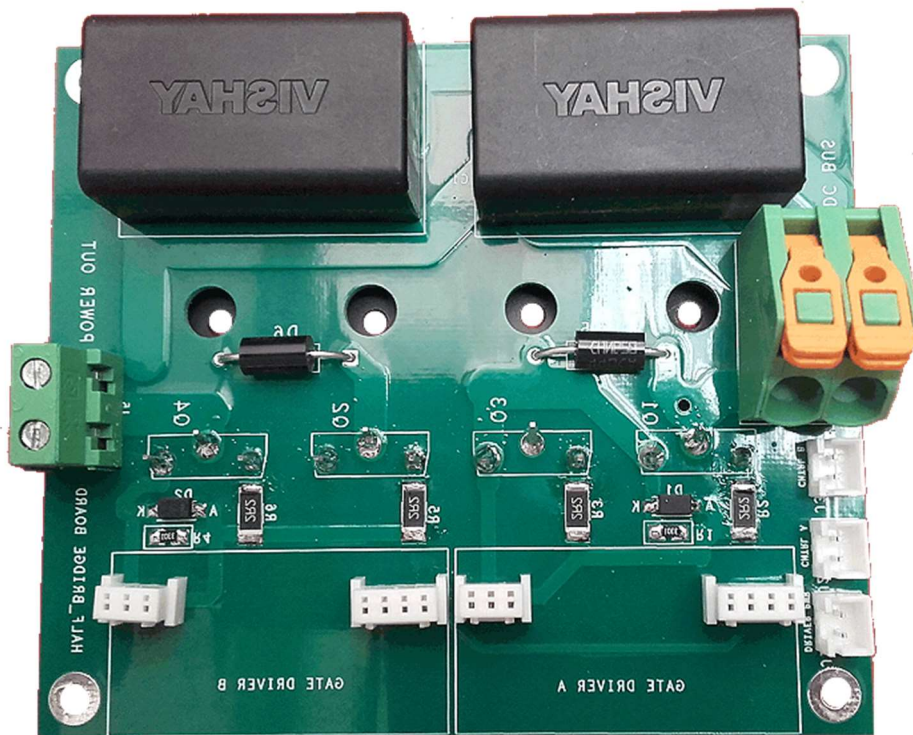


INVERSOR SEMIPIENTE PARA CALENTAMIENTO POR INDUCCION Le-HB2

- Drivers aislados, en la propia placa
- Snubber Capacitors de alta calidad
- Compatibilidad con IGBTs, MOSFETs, y SiC Mosfets
- 2x2 Transistores en paralelo para mayor corriente
- Voltaje de alimentación de hasta 700V.
- Corriente media permitida por las pistas PCB de hasta 40A.



El módulo es una versión compacta de un inversor semipiente con muy baja inductancia parásita, lo que le permite ser utilizado en un gran número de aplicaciones. Cuenta con todos los elementos necesarios, para la implementación de convertidores profesionales: Red Snubbers de gran calidad, drivers en la propia placa, dos transistores en paralelo por switch, Diodos TVS de protección, etc.

En la placa pueden ser usados todo tipo de Mosfets e IGBTs con los encapsulados del tipo TO-247 y TO-264 dispuestos de una forma cómoda, para poder ser atornillados a un disipador de calor.

Dos de ellos pueden formar un puente H capaz de generar una potencia mayor de 20 kW si se alimenta con 600V DC desde un rectificador trifásico de seis pulsos, o más de

8 kilovatios si lo alimentamos desde un rectificador de onda completa de la red monofásica de 230V.

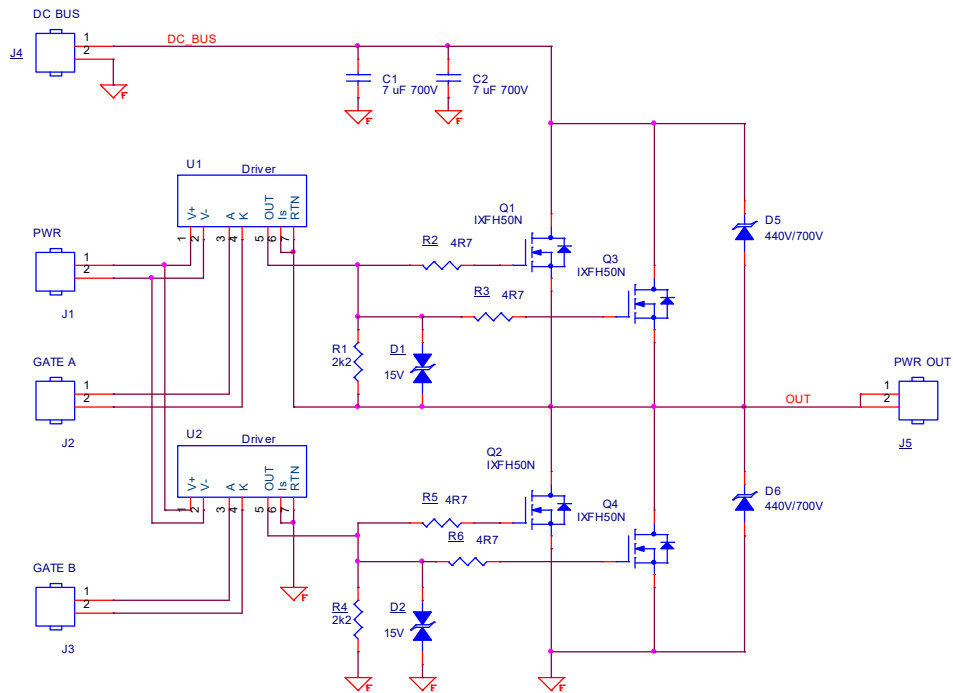
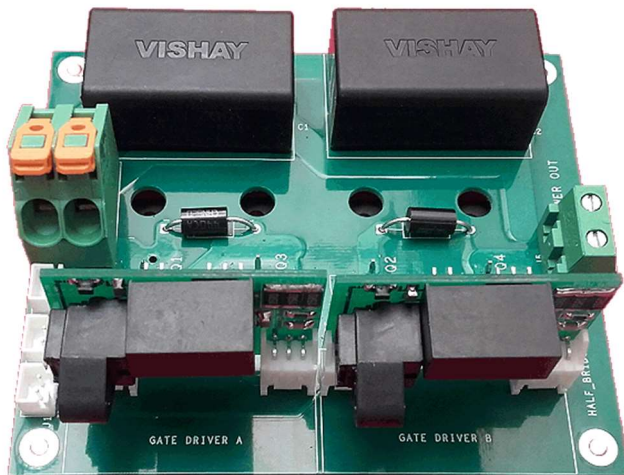


Fig.1. Esquema eléctrico del módulo.

Todos los capacitores usados tienen muy bajo valor ESR y LSR, para su funcionamiento efectivo a alta frecuencia.

El módulo es compatible con la nueva generación de drivers de compuerta de fabricación propia de ledoelectronics.



Probada satisfactoriamente en un horno de calentamiento por inducción de 4 KW a 950 kHz, con transistores de carburo de silicio Sic MOSFETs.